

a 2017 0049

Invenția se referă la domeniul tehnologiei materialelor pentru ingineria electronică, în special la domeniul preparării materialelor sub formă de monocristale și poate fi utilizată la producerea monocristalelor de arseniură de niobiu sau tantal.

Procedeeul de obținere a monocristalelor de arseniură de tantal sau niobiu prin metoda reacției chimice de transport într-un volum închis cu un gradient de temperatură și folosind iodul ca agent de transport, în care bucăți de folii de tantal sau niobiu, arsen și iod se încarcă în fiole și se plasează într-un cuptor cu trei zone de temperaturi de 610°C, 850°C și 800°C, zona cu temperatura de 850°C fiind la mijlocul fiolei, arsenul - în zona cu temperatura de 610°C, tantalul sau niobiul - în zona cu temperatura de 800°C, iar cantitatea de agent de transport (iod) se alege în dependență de limitele de presiune pentru fiola aleasă pentru sinteză.

Revendicări: 2

Figuri: 3